

<<电子信息类专业英语>>

图书基本信息

书名：<<电子信息类专业英语>>

13位ISBN编号：9787111256892

10位ISBN编号：7111256891

出版时间：2009-3

出版时间：机械工业出版社

作者：温丹丽

页数：156

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

前言

《电子信息类专业英语》是高职高专“十一五”电子信息类专业规划教材之一。

通过学习专业英语，可以扩大学生的专业词汇量，提高学生英文专业文章的阅读能力，同时使学生获得更多的电子信息类专业方面的新知识和新的发展动态。

本教材具有如下特点：1) 教材内容安排上，按电子信息类专业所涉及的专业课程分成电子技术基础及应用、仪器仪表与测量方法、家用电器、传感器及应用、数字信号与转换、微电子学与平面工艺、封装技术及电子设计自动化软件等内容。

全书共12单元，每个单元3篇课文，前两篇为精读课文，第3篇作为阅读材料。

每个单元突出一个领域的技术与应用，是电子信息类的通用专业英语教材。

2) 选材新颖，点面结合，注重各专业、学科间知识的相关性。

选材不仅能体现专业性还能体现趣味性，同时选取了大量的新知识和新的应用实例。

3) 每篇精读课文后都提供了课后练习题，具有一定的针对性，有利于检验学生掌握课文的程度，便于教师更好地进行教学活动；每个单元中的阅读材料，可作为学生自学内容。

学生通过阅读，可以了解更多的专业知识。

4) 为了便于扩大学生的专业词汇量，书中更注重专业词汇的介绍。

本书还介绍了专业英语语言的结构特点、专业英语的翻译技巧和专业构词法，对学生掌握和理解专业词汇会有很大的帮助。

另外也介绍了一些常用的数字、数学表达式与英语读法等。

本教材由沈阳师范大学职业技术学院温丹丽担任主编，大连职业技术学院邹显圣和沈阳建筑大学外国语学院程娟担任副主编，沈阳药科大学高等职业技术学院孙清、辽宁装备制造职业技术学院张君薇和沈阳师范大学职业技术学院林淑芝参与编写。

具体分工如下：温丹丽编写了第6单元、第9至12单元、第7单元和第8单元的阅读材料部分；邹显圣编写了第1至3单元；程娟编写了专业英语语言的结构特点，专业英语翻译技巧，构词法，数字、数学表达式与英文读法等部分；孙清编写了第4单元和第5单元；张君薇编写了第7单元和第8单元的精读课文部分；林淑芝编写了希腊字母及其读法、常用电子信息类专业英语词汇、常用电子信息类专业英语词汇缩写和电子信息类相关专业课程名称。

全书由东北大学外国语学院韩忠军担任主审，在此表示衷心的感谢。

限于编者水平有限，书中难免有不足、疏漏之处，敬请广大读者批评指正。

<<电子信息类专业英语>>

内容概要

本教材为高职高专“十一五”电子信息类专业规划教材之一。

编写内容按教育部高职高专电子信息类专业所涉及的专业课程分为电子技术基础及应用、仪器仪表与测量方法、家用电器、传感器及应用、数字信号与转换、微电子学与平面工艺、封装技术及电子设计自动化软件等内容。

全书共12个单元，每个单元3篇课文，前2篇为精读课文，第3篇作为阅读材料。

每篇精读课文后都提供了课后练习题，具有一定的针对性，有利于检验学生掌握课文的程度。

教材在选材上独具匠心，力求不仅能体现专业性。

还能体现趣味性；点面结合，每个单元不仅突出一个领域的技术与应用，同时还注重各专业、学科间知识的相关性；贴近实际，不仅收录了大量专业实用词汇，还选取了大量的新知识和新的应用实例。

本教材旨在扩大学生的专业词汇量，提高学生英文专业文章的阅读能力，同时使学生获得更多的电子信息类专业方面的新知识并了解新的发展动态。

本书可作为高等职业教育电子信息类专业的英语教材，也可供相应水平的读者与技术人员参考使用。

书籍目录

前言 Unit One The Basis of Electronic Technology Passage One Diode and Transistor Passage Two Kirchhoff ' S Law and Linear Circuit Analysis Reading Material FieldEffect Transistors 专业英语语言的结构特点 Unit Two Circuits and Power SuppliesI Passage One Digital Circuits Passage Two Digital Logic Circuits Reading Material Power SuppliesI 专业英语翻译技巧 Unit Three Analog Instruments Passage One Muhimeter and Oscilloscope Passage Two Voltmeter and Ohmmeter Reading Material Analog Oscilloscope and Signal Generator 数字、数学表达式与英文读法 Unit Four Digital Instruments Passage One Electronic Digital Counter and Digiml Frequency Counter Passage Two Digital Oscilloscope and Digital Multimeter Reading Material Digital Displays 构词法(I) 英语构词的三种方法 Unit Five Fundamentals of Measurement and Testing Passage One Definition of Measurement Passage Two Measurement Methods Reading Material Temperature Measurement 构词法() 名词前缀与后缀 Unit Six Electric Appliances Passage One How Do Liquid Crystal Display TVs Work? Passage Two Microwave Ovens Reading Material Refrigerators 构词法() 动词前缀与后缀 Unit Seven Sensors Passage One Analog and Digital Sensors Passage Tw0 Smart Sensors Reading Material Sensor Classifications , Selections and Common Technologies 构词法(IV) 形容词、副词的前缀与后缀 Unit Eight Application of Sensors Passage One Sensors in Intelligent Robots Passage Two Thermistors Reading Material Digital Barometer Sensor Module and Humidity Sensor Module 构词法(V) 词尾与词性 Unit Nine Digital Signal and Conversion Passage One Digital Signal Processing Passage Two Digital Signal Processors Reading Material Information Conversion Technique 希腊字母及其读法 Unit Ten Microelectronics and Planar Process Passage One Introduction to Microelectronics= Passage Two Basic Planar Process Reading Material Microprocessor and Its Construction 常用电子信息类专业英语词汇 Unit Eleven Packing Technology Passage One The Basis of PCB Passage Two Soldering Methods in SMT Reading Material Soldering Methods in Detail 常用电子信息类专业英语词汇缩写 Unit Tweive Electronic Design Automation Passage One Features of Electronics Workbench Software Passage Two About Advanced PCB 25 in Protel 2000 Reading Material Applications of EDA in Simulation Experiments 电子信息类相关专业课程名称 参考答案 参考文献

章节摘录

Now let us see how the MOSFET as Fig.1-5 to operate in a circuit. We suppose that the substrate and gate terminals are connected to the source, along with a battery between D and S that makes $U_{DS} = -6V$. Thus U_{GS} initially (最初, 开头) is equal to zero. Then suppose U_{CS} is changed from zero to IOV with U_{OS} unchanged. The negative gate attracts positive holes. When U_{GS} is beyond a threshold value U_{th} the positive holes are attracted more enough so that a localized inversion layer is formed directly below the gate. This serves as a conducting channel between the source and the drain electrodes (电极). As shown in Fig.1-6 ' there is a continuous P region from the source to the drain and U_{OS} causes holes to flow from the source through the channel to the drain. This is a majority-carrier current, which flows by the drift process. Because their operation depends on only a single type of charge carrier, FET is unipolar (单极的) transistor. In contrast, the bipolar (双极的) junction transistor requires both hole and electron currents. In this case, we see that with zero gate voltage and U_{GS} positive, there is no conducting channel but when U_{CS} is sufficiently negative, a channel is formed and current flows. The more negative we make U_{CS} , the greater the current. A MOSFET that conducts appreciable current only when a nonzero voltage is applied to the gate is called an enhancement-mode field-effect transistor.

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>